



(19)대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) 。 Int. Cl.
G02F 1/136 (2006.01)

(11) 공개번호 10-2007-0054516
(43) 공개일자 2007년05월29일

(21) 출원번호 10-2005-0112596
(22) 출원일자 2005년11월23일
심사청구일자 2005년11월23일

(71) 출원인 삼성에스디아이 주식회사
경기 수원시 영통구 신동 575

(72) 발명자 김도영
울산광역시 울주군 삼남면 가천리 818 삼성SDI
허해진
울산광역시 울주군 삼남면 가천리 818 삼성SDI

(74) 대리인 신영무

전체 청구항 수 : 총 11 항

(54) 액정표시장치 어레이 기판 및 그 제조방법

(57) 요약

본 발명의 실시예에 의한 액정표시장치 어레이 기판은, 기판 상에 형성되는 다수의 게이트 배선 및 상기 게이트 배선에 교차하도록 다수 형성되는 데이터 배선과; 상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 교차부에 형성되는 박막트랜지스터와; 상기 게이트 배선에 평행하고 요철 형상 패턴으로 형성되는 스토리지 캐패시터 제 1전극과; 상기 박막트랜지스터의 드레인 전극과 일체형으로 이루어지며 상기 제 1전극 상에 형성되는 스토리지 캐패시터 제 2전극과; 상기 드레인 전극과 전기적으로 연결되는 화소 전극이 포함되어 구성됨을 특징으로 한다.

이와 같은 본 발명에 의하면, 스토리지 캐패시터의 제 1전극을 위상 쉬프트 마스크(Phase Shift Mask) 또는 슬릿 마스크(Slit Mask)를 이용하여 요철형상으로 형성하여 실제 면적을 넓히고, 스토리지 캐패시터의 제 2전극을 화소전극과 전기적으로 연결되는 드레인 전극 영역을 사용하여 제 1 및 제 2전극간의 거리를 좁혀 전체적으로 스토리지 캐패시터의 정전용량을 증가시키는 장점이 있다.

대표도

도 3

특허청구의 범위

청구항 1.

기판 상에 형성되는 다수의 게이트 배선 및 상기 게이트 배선에 교차하도록 다수 형성되는 데이터 배선과;

상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 교차부에 형성되는 박막트랜지스터와;

상기 게이트 배선에 평행하고 요철 형상 패턴으로 형성되는 스토리지 캐패시터 제 1전극과;

상기 박막트랜지스터의 드레인 전극과 일체형으로 이루어지며 상기 제 1전극 상에 형성되는 스토리지 캐패시터 제 2전극과;

상기 드레인 전극과 전기적으로 연결되는 화소 전극이 포함되어 구성됨을 특징으로 하는 액정표시장치 어레이 기판.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 스토리지 캐패시터 제 1전극은 게이트 배선을 형성하는 물질과 동일 물질로 형성됨을 특징으로 하는 액정표시장치 어레이 기판.

청구항 3.

제 1항에 있어서,

상기 스토리지 캐패시터 제 1전극은 게이트 배선과 동일한 층에 형성됨을 특징으로 하는 액정표시장치 어레이 기판.

청구항 4.

제 1항에 있어서,

상기 스토리지 캐패시터 제 1전극 및 스토리지 캐패시터 제 2전극 사이에는 절연층이 형성됨을 특징으로 하는 액정표시장치 어레이 기판.

청구항 5.

제 4항에 있어서,

상기 절연층은 게이트 절연막임을 특징으로 하는 액정표시장치 어레이 기판.

청구항 6.

제 1항에 있어서,

상기 스토리지 캐패시터 제 1전극의 요철 형상 패턴은 마스크 공정 시 상기 제 1전극이 형성되는 영역에 대하여 위상 쉬프트 마스크(Phase Shift Mask) 또는 슬릿 마스크(Slit Mask)에 의한 노광을 통해 형성됨을 특징으로 하는 액정표시장치 어레이 기판.

청구항 7.

제 1항에 있어서,

상기 박막트랜지스터(T)는 게이트전극, 소스전극 및 드레인전극과 액티브층으로 구성되고, 상기 소스전극은 상기 데이터 배선과 연결되며 상기 게이트전극은 상기 데이터배선과 교차하여 상기 화소영역을 정의하는 게이트배선과 연결되도록 구성됨을 특징으로 하는 액정표시장치 어레이 기판.

청구항 8.

기판 상에 다수의 게이트 배선 및 상기 게이트 배선에 평행하게 요철 형상 패턴의 스토리지 캐패시터 제 1전극이 형성되는 단계와;

상기 게이트 배선 및 스토리지 캐패시터 제 1전극 상에 절연막이 형성되는 단계와;

상기 절연막 상에 다수의 게이트 배선과 교차하는 다수의 데이터 배선 및 상기 스토리지 캐패시터 제 1전극과 소정 면적이 중첩되도록 스토리지 캐패시터 제 2전극이 형성되는 단계가 포함됨을 특징으로 하는 액정표시장치 어레이 기판 제조방법.

청구항 9.

제 8항에 있어서,

상기 스토리지 캐패시터 제 1전극의 요철 형상 패턴은 마스크 공정 시 상기 제 1전극이 형성되는 영역에 대하여 위상 쉬프트 마스크(Phase Shift Mask) 또는 슬릿 마스크(Slit Mask)에 의한 노광을 통해 형성됨을 특징으로 하는 액정표시장치 어레이 기판 제조방법.

청구항 10.

제 1항에 있어서,

상기 보호막 상의 상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 교차에 의해 정의되는 화소 영역에 화소 전극이 형성되는 단계가 더 포함됨을 특징으로 하는 액정표시장치 어레이 기판 제조방법.

청구항 11.

제 10항에 있어서,

상기 화소 전극은 보호막의 소정 위치에 형성된 콘택홀을 통해 스토리지 제 2전극과 일체로 연결된 드레인 전극과 전기적으로 연결됨을 특징으로 하는 액정표시장치 어레이 기판 제조방법.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 스토리지 캐패시터의 면적을 줄이면서도 용량을 유지토록 하는 액정표시장치 어레이 기판 및 그 제조방법에 관한 것이다.

일반적으로, 화상 정보를 화면에 나타내는 화면 표시 장치들 중에서 브라운관 표시 장치(Cathode Ray Tube, CRT)가 지금까지 가장 많이 사용되어 왔는데, 이것은 표시 면적에 비해 부피가 크고 무겁기 때문에 사용하는데 많은 불편함이 따랐다.

이에 따라, 표시 면적이 크더라도 그 두께가 얇아서 어느 장소에서든지 쉽게 사용할 수 있는 박막형 평판 표시 장치가 개발되었고, 점점 브라운관 표시 장치를 대체하고 있다. 특히, 액정표시장치(Liquid Crystal Display, LCD)는 표시 해상도가 다른 평판 표시 장치보다 뛰어나고, 동화상을 구현할 때 그 품질이 브라운관에 비할 만큼 반응 속도가 빠른 특성을 나타내고 있다.

알려진 바와 같이, 액정표시장치의 구동 원리는 액정의 광학적 이방성과 분극 성질을 이용한 것이다. 액정은 구조가 가늘고 길기 때문에 분자 배열에 방향성과 분극성을 갖고 있는 액정 분자들에 인위적으로 전자기장을 인가하여 분자배열 방향을 조절할 수 있다. 따라서, 배향 방향을 임의로 조절하면 액정의 광학적 이방성에 의하여 액정 분자의 배열 방향에 따라 빛을 투과 혹은 차단시킬 수 있게 되어, 색상 및 영상을 표시할 수 있게 된다.

그리고, 액티브 매트릭스형 액정표시장치는, 매트릭스 형태로 배열된 각 화소에 비선형 특성을 갖춘 액티브 소자를 부가하고, 이 소자의 스위칭 특성을 이용하여 각 화소의 동작을 제어하는 것으로서, 액정의 전기광학효과를 통하여 메모리 기능을 구현한 것이다.

한편, 이와 같은 액티브 매트릭스형 액정표시장치는, 표시되는 이미지의 균일성(uniformity)을 확보하기 위하여 데이터 배선을 통하여 입력된 신호 전압을 다음 입력 시까지 일정시간 동안 유지시켜 줄 필요가 있으며, 이를 위하여 액정 셀과 평행하게 스토리지 캐패시터(storage capacitor)를 형성시켜 준다.

그리고, 액정표시장치에 형성되는 스토리지 캐패시터는 충전을 위한 전극을 사용하는 방식에 따라 온컴먼(on common) 방식과 온게이트(on gate) 방식으로 구분될 수 있다.

이들 방식을 비교하면, 온게이트 방식은 (n-1)번째의 주사선 일부를 (n)번째 화소의 충전 전극으로 사용하는 방식으로 개구율의 감소 정도가 적고, NW 방식(Normally White Mood)에서 점결함 발생시 눈에 쉽게 띄지 않으며, 수율이 좋은 반면에 주사신호 시간이 길어지는 단점이 있다.

그리고, 온컴먼 방식은 충전 전극을 별도로 배선하여 사용하는 방식으로, 주사신호 시간이 짧은 반면에 개구율의 감소 정도가 크고, NW 방식에서 점결함 발생시 눈에 쉽게 띄며, 수율이 떨어진다는 단점이 있다.

이후, 도 1을 참조하여 종래의 온컴먼 방식의 스토리지 캐패시터에 대하여 간략하게 설명해 보기로 한다.

도 1은 종래 액정표시장치에 형성되는 온컴먼 방식의 스토리지 캐패시터가 형성된 액정표시장치 어레이 기판을 개략적으로 나타낸 도면이다.

도 1을 참조하면, 온컴먼 방식의 스토리지 캐패시터가 형성된 액정표시장치 어레이 기판은, 하판인 절연기판 상에 다수의 게이트 배선(9)(19)과 데이터 배선(10)(20)이 교차하여 교차부를 형성하고 있다. 임의의 데이터 배선(예컨대 10)과 임의의 게이트 배선(예컨대 19)이 교차하는 교차부에는 상기 데이터 배선(10)과 동일 배선인 소스 전극(11) 및 드레인 전극(12)과, 상기 게이트 배선(19)과 동일 배선인 게이트 전극(14)과, 반도체 층(13)을 구비하여 이루어진 박막트랜지스터(TFT)가 형성되어 있다. 또한, 화소전극(15)이 주사선(19) 및 신호선(10)과 일정 간격을 두고 드레인 전극(12)에 연결되어 형성되어 있다. 그리고, 스토리지 캐패시터의 제 1전극(16)이 상기 게이트 배선(19)과 평행하게 위치하되, 상기 화소 전극(15)을 횡단하여 형성되어 있다.

이와 같은 구성을 갖는 온컴먼 방식의 스토리지 캐패시터는, 스토리지 캐패시터의 제 2전극인 상기 화소전극(15)과, 상기 게이트 전극(14)과 동일 물질로 형성되는 상기 스토리지 캐패시터의 제 2전극(16) 사이에 전하를 축전시키게 된다. 이때, 상기 스토리지 캐패시터에 축전되는 정전용량은, 알려진 바와 같이 $C = \epsilon \cdot A / d$ 에 의하여 축전되는 정전용량의 크기가 결정된다. 여기서, C는 정전용량, ϵ 는 유전상수, A는 전극의 면적을 나타내며, d는 전극 간의 거리를 나타낸다.

한편, 액정표시장치에 표시되는 이미지의 균일성(uniformity)을 확보하기 위해서는 상기 스토리지 캐패시터에 의해 축전되는 정전용량은 클 것이 요구되나, 앞서 설명한 종래의 스토리지 캐패시터는 정전용량을 키우기 위해 면적을 넓힐 경우 개구율이 감소하며, 이에 따라 전면 휘도가 전체적으로 감소된다는 단점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 온컴먼 방식의 스토리지 캐패시터가 구비되는 액정표시장치에 있어서, 상기 스토리지 캐패시터의 제 1전극을 위상 쉬프트 마스크(Phase Shift Mask) 또는 슬릿 마스크(Slit Mask)를 이용하여 요철형상으로 형성하여 실제 면적을 넓히고, 스토리지 캐패시터의 제 2전극을 화소전극과 전기적으로 연결되는 드레인 전극 영역을 사용하여 제 1 및 제 2전극간의 거리를 좁혀 전체적으로 스토리지 캐패시터의 정전용량을 증가시키도록 하는 액정표시장치 어레이 기판 및 그 제조방법을 제공함에 목적이 있다.

발명의 구성

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 실시예에 의한 액정표시장치 어레이 기판은, 기판 상에 형성되는 다수의 게이트 배선 및 상기 게이트 배선에 교차하도록 다수 형성되는 데이터 배선과; 상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 교차부에 형성되는 박막트랜지스터와; 상기 게이트 배선에 평행하고 요철 형상 패턴으로 형성되는 스토리지 캐패시터 제 1전극과; 상기 박막트랜지스터의 드레인 전극과 일체형으로 이루어지며 상기 제 1전극 상에 형성되는 스토리지 캐패시터 제 2전극과; 상기 드레인 전극과 전기적으로 연결되는 화소 전극이 포함되어 구성됨을 특징으로 한다.

여기서, 상기 스토리지 캐패시터 제 1전극은 게이트 배선을 형성하는 물질과 동일 물질로 형성되고, 게이트 배선과 동일한 층에 형성됨을 특징으로 한다.

또한, 상기 스토리지 캐패시터 제 1전극 및 스토리지 캐패시터 제 2전극 사이에는 절연층이 형성되고, 상기 절연층은 게이트 절연막임을 특징으로 한다.

또한, 상기 스토리지 캐패시터 제 1전극의 요철 형상 패턴은 마스크 공정 시 상기 제 1전극이 형성되는 영역에 대하여 위상 쉬프트 마스크(Phase Shift Mask) 또는 슬릿 마스크(Slit Mask)에 의한 노광을 통해 형성됨을 특징으로 한다.

또한, 상기 박막트랜지스터(T)는 게이트전극, 소스전극 및 드레인전극과 액티브층으로 구성되고, 상기 소스전극은 상기 데이터 배선과 연결되며 상기 게이트전극은 상기 데이터배선과 교차하여 상기 화소영역을 정의하는 게이트배선과 연결되도록 구성됨을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 실시예에 의한 액정표시장치 어레이 기판 제조방법은, 기판 상에 다수의 게이트 배선 및 상기 게이트 배선에 평행하게 요철 형상 패턴의 스토리지 캐패시터 제 1전극이 형성되는 단계와; 상기 게이트 배선 및 스토리지 캐패시터 제 1전극 상에 절연막이 형성되는 단계와; 상기 절연막 상에 다수의 게이트 배선과 교차하는 다수의 데이터 배선 및 상기 스토리지 캐패시터 제 1전극과 소정 면적이 중첩되도록 스토리지 캐패시터 제 2전극이 형성되는 단계가 포함됨을 특징으로 한다.

또한, 상기 스토리지 캐패시터 제 1전극의 요철 형상 패턴은 마스크 공정 시 상기 제 1전극이 형성되는 영역에 대하여 위상 쉬프트 마스크(Phase Shift Mask) 또는 슬릿 마스크(Slit Mask)에 의한 노광을 통해 형성됨을 특징으로 한다.

또한, 상기 보호막 상의 상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 교차에 의해 정의되는 화소 영역에 화소 전극이 더 형성되며, 상기 화소 전극은 보호막의 소정 위치에 형성된 콘택홀을 통해 스토리지 제 2전극과 일체로 연결된 드레인 전극과 전기적으로 연결됨을 특징으로 한다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 보다 상세히 설명하도록 한다.

도 2는 본 발명의 실시예에 의한 액정표시장치 어레이 기판의 평면도이고, 도 3은 도 2의 특정 부분(I-I')에 대한 단면도이다.

도시된 바와 같이 본 발명의 실시예에 의한 액정표시장치 어레이 기판은, 제 1기판(100) 상에 서로 교차 형성된 게이트 배선(90) 및 데이터 배선(92)에 의해 정의되는 화소영역(P)과 상기 화소영역(P) 상에 형성된 화소전극(120)과 박막트랜지스터(T), 스토리지 캐패시터(Cst)를 포함하여 구성된다.

단, 도시되지 않았으나, 본 발명에 의한 액정표시장치는 상기 각 화소영역(P)에 대응되는 영역에 형성되는 컬러필터와, 상기 컬러필터의 사이 및 상기 박막트랜지스터(T) 및 스토리지 캐패시터(Cst)의 소정 부분에 대응되는 영역에 형성되는 블랙매트릭스, 상기 컬러필터와 블랙매트릭스 상에 투명한 공통전극이 형성된 제 2기판과; 상기 제 1기판과 제 2기판 사이에 충전되는 액정이 더 포함되어 구성된다.

상기 스위칭 소자인 박막트랜지스터(T)는 매트릭스형태(matrix type)로 각 화소영역(P)의 일측에 위치하고, 이러한 다수의 박막트랜지스터를 교차하여 지나가는 게이트배선(90)과 데이터배선(92)이 형성된다. 상기 화소영역(P)은 상기 게이트배선(90)과 데이터배선(92)이 교차하여 정의되는 영역이다. 상기 화소영역(P)상에 형성되는 화소전극(120)은 인듐-틴-옥사이드(indium-tin-oxide : ITO)와 같이 빛의 투과율이 비교적 뛰어난 투명 도전성 금속을 사용한다.

이와 같은 액정표시장치는 상기 화소전극(120) 상에 위치한 액정층이 상기 박막트랜지스터(T)로부터 인가된 신호에 의해 배향되고, 상기 액정층의 배향정도에 따라 상기 액정층을 투과하는 빛의 양을 조절하는 방식으로 화상을 표현할 수 있다.

상기 게이트배선(90)은 상기 박막트랜지스터(T)의 제 1 전극인 게이트전극(110)을 구동하는 펄스전압을 전달하며, 상기 데이터배선(92)은 상기 박막트랜지스터(T)의 제 2 전극인 소스전극(114)을 구동하는 신호전압을 전달하는 수단이다.

상기 박막트랜지스터(T)는 게이트전극(110)과 소스전극(114)과 드레인전극(116)과 액티브층(active layer)(112)으로 구성되고, 상기 소스전극(114)은 데이터배선(92)과 연결되며 상기 게이트전극(110)은 상기 데이터배선(92)과 교차하여 화소영역(P)을 정의하는 게이트배선(90)과 연결되도록 구성된다.

즉, 상기 게이트 전극(110)에 소정의 펄스 전압이 인가되면 상기 액티브층(112)이 활성화되며, 이에 상기 드레인 전극(116)은 하부의 액티브층(112)을 거쳐 소정 간격 이격된 소스 전극(114)을 통해 상기 소스 전극(114)과 연결된 데이터 배선(92)으로부터의 신호 전압을 전달 받게 되며, 상기 드레인 전극(116)은 콘택홀(117)을 통해 화소 전극(120)과 전기적으로 연결되어 결과적으로 상기 신호 전압은 화소 전극(120)에 인가된다.

또한, 도 2 및 도 3을 참조하면, 상기 게이트 배선(90)과 평행하게 스토리지 캐패시터의 제 1전극(130)이 형성되며, 절연층(140) 및 상기 드레인 전극(116)과 일체로 형성되는 제 2전극(136)이 상기 제 1전극(130) 상에 순차적으로 형성되어 스토리지 캐패시터(Cst)를 이룬다. 이 때 상기 절연층(132)은 게이트 절연막이 될 수 있다.

본 발명의 경우 상기 제 1 전극(130)은 게이트 배선(90)과 동일한 금속으로 형성되나, 상기 제 1전극(130)은 게이트 배선(90)과는 달리 요청 형상의 패턴으로 이루어짐을 특징으로 한다.

이는 마스크 공정시 상기 제 1전극(130)이 형성되는 영역에 대하여 위상 쉬프트 마스크(Phase Shift Mask) 또는 슬릿 마스크(Slit Mask)를 통해 노광을 수행함으로써 얻을 수 있다.

이를 통해 스토리지 캐패시터의 제 1전극(130) 면적이 증가되는 효과를 얻을 수 있게 되어 스토리지 캐패시터의 정전용량을 높일 수 있는 것이다.

또한, 본 발명은 스토리지 캐패시터의 제 2전극(136)으로 화소 전극(120)이 아닌 드레인 전극부(116, 136)를 사용함을 그 특징으로 한다.

이 때, 상기 드레인 전극부는 드레인 전극(116)과 상기 드레인 전극과 일체로 형성된 제 2전극(136)을 의미한다.

도시된 바와 같이 상기 드레인 전극부는 보호층(140) 상에 형성된 콘택홀(117)을 통해 화소 전극(120)과 접촉될 뿐 아니라 상기 제 1전극(130)과 중첩되도록 넓은 면적으로 형성되어 스토리지 캐패시터의 상부전극(136)으로 사용된다.

즉, 상기 드레인 전극(116)과 일체로 형성되고 상기 제 1전극과 중첩되는 제 2전극(136)이 구비됨으로써, 결과적으로 스토리지 캐패시터의 양 전극(130, 136)간 간격을 줄일 수 있게 되어 스토리지 캐패시터의 정전용량을 더욱 증가시킬 수 있게 되는 것이다.

따라서, 각 화소 영역마다 필요한 정전용량의 값이 정해져 있을 경우, 본 발명에 의하면 종래에 비해 좁은 면적의 스토리지 캐패시터를 통해 종래와 동일한 정전용량 값을 얻을 수 있으므로 결과적으로 개구율을 확대시키는 효과를 얻을 수 있으며, 이에 따라 액정표시장치의 전체 휘도 또한 증가하게 된다.

상기와 같이 구성되는 액정표시장치 어레이 기판은 증착 공정, 포토리소그래피(photolithography : 이하 '포토') 공정 및 식각 공정 등에 순차적으로 의해 형성된다. 여기서, 상기 포토 공정은 포토레지스트(photo resist : 이하 'PR')가 빛을 받으면 화학반응을 일으켜서 성질이 변화하는 원리를 이용하여, 얻고자 하는 패턴(pattern)의 마스크(mask)를 사용하여 빛을 선택적으로 PR에 조사함으로써 마스크의 패턴과 동일한 패턴을 형성시키는 공정을 말하며, 이러한 포토 공정은 일반 사진의 필름(film)에 해당하는 포토레지스트를 도포하는 PR 도포 공정, 마스크를 이용하여 선택적으로 빛을 조사하는 노광 공정, 다음에 현상액을 이용하여 빛을 받은 부분의 PR을 제거하여 패턴을 형성시키는 현상 공정으로 구성된다.

도 4a 내지 도 4c는 본 발명의 실시예에 의한 액정표시장치의 제조 공정을 나타내는 평면도 및 단면도이다.

먼저 도 4a를 참조하면, 소정의 금속을 절연 기판(100) 전면에 증착하고 마스크를 이용하여 패턴하고, 현상함으로써, 게이트 배선(90)과 게이트전극(110) 및 스토리지 캐패시터의 제 1전극(130)을 형성한다.

단, 본 발명의 경우 상기 스토리지 캐패시터 제 1전극(130)은 게이트 배선(90) 및 게이트 전극(110)과 달리 요철 형성을 갖도록 형성됨을 특징으로 하며, 이를 위해 상기 제 1 전극(130) 상부에 위치하는 마스크는 게이트 배선 및 게이트 전극 패턴을 형성하기 위한 마스크와 달리 위상 쉬프트 마스크(Phase Shift Mask) 또는 슬릿 마스크(Slit Mask)를 이용하여 노광을 수행한다.

다음으로는 도 4b에 도시된 바와 같이 상기 게이트 라인(90) 등이 형성된 기판(100) 상에 게이트 절연막(132)과, 비정질 반도체층(실리콘층)과 불순물이 함유된 비정질 반도체층(실리콘층)과 도전성 금속층을 증착하고, 포토 및 식각 공정을 통해 상기 게이트 라인(90)과 교차하여 화소영역을 정의하는 데이터 라인(92)과, 상기 데이터 라인(90)에서 수직하게 소정면적으로 돌출 형성된 소스전극(114)과, 이와 소정 간격 이격된 드레인 전극부(116, 136)를 형성한다.

이 때, 상기 드레인 전극부는 상기 스토리지 캐패시터의 제 1전극(130)과 중첩될 수 있도록 넓은 면적으로 형성되며, 이에 상기 제 1전극과 중첩되는 영역에 형성되는 드레인 전극부는 스토리지 캐패시터의 제 2전극(136)이 된다.

그 다음 상기 패턴된 금속층을 식각 방지막으로 하여 노출된 불순물 비정질 실리콘층을 식각하여, 상기 소스전극(114)과 드레인전극(116) 상에 상기 비정질 실리콘층이 노출되도록 함으로써 액티브층(112)을 구현하고, 이를 통해 게이트 전극(110), 소스/드레인 전극(114, 116) 및 액티브층(112)을 구성되는 박막트랜지스터가 형성된다.

다음으로 도 4c에 도시된 바와 같이 상기 데이터 라인(92) 등이 형성된 기판 상에 절연물질로 보호층(140)을 형성한 후 패턴하여, 상기 드레인전극부(116, 136) 상부에 콘택홀(117)을 형성하고, 상기 콘택홀을 통해 상기 드레인전극부와 접촉하는 화소전극(120)을 형성한다.

즉, 상기 화소전극(120)은 상기 콘택홀(117)을 통해 드레인 전극부와 전기적으로 접속하게 되며, 이에 따라 스토리지 캐패시터의 제 2전극(136)과도 전기적으로 연결되는 것이다.

결과적으로 본 발명은 상기 스토리지 캐패시터의 제 1전극(130)이 위상 쉬프트 마스크(Phase Shift Mask) 또는 슬릿 마스크(Slit Mask)에 의한 노광 공정을 통해 요철 형상을 갖도록 함으로써, 스토리지 캐패시터의 제 1전극 면적이 증가되는 효과를 얻을 수 있게 되고, 또한, 본 발명은 스토리지 캐패시터의 제 2전극(136)으로 화소 전극이 아닌 상기 드레인 전극부를 사용하여 스토리지 캐패시터의 양 전극간 간격을 줄일 수 있게 되어 스토리지 캐패시터의 정전용량을 더욱 증가시킬 수 있게 됨을 특징으로 한다.

따라서, 각 화소 영역마다 필요한 정전용량의 값이 정해져 있을 경우, 본 발명에 의하면 종래에 비해 좁은 면적의 스토리지 캐패시터를 통해 종래와 동일한 정전용량 값을 얻을 수 있으므로 결과적으로 개구율을 확대시키는 효과를 얻을 수 있으며, 이에 따라 액정표시장치의 전체 휘도 또한 증가하게 된다.

발명의 효과

이와 같은 본 발명에 의하면, 스토리지 캐패시터의 제 1전극을 위상 쉬프트 마스크(Phase Shift Mask) 또는 슬릿 마스크(Slit Mask)를 이용하여 요철형상으로 형성하여 실제 면적을 넓히고, 스토리지 캐패시터의 제 2전극을 화소전극과 전기적으로 연결되는 드레인 전극 영역을 사용하여 제 1 및 제 2전극간의 거리를 좁혀 전체적으로 스토리지 캐패시터의 정전용량을 증가시키는 장점이 있다.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의하여 정하여져야만 한다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 액정표시장치에 형성되는 온컴먼 방식의 스토리지 캐패시터가 형성된 액정표시장치 어레이 기판을 개략적으로 나타낸 도면.

도 2는 본 발명의 실시예에 의한 액정표시장치 어레이 기판의 평면도.

도 3은 도 2의 특정 부분(I - I')에 대한 단면도.

도 4a 내지 도 4c는 본 발명의 실시예에 의한 액정표시장치의 제조 공정을 나타내는 평면도 및 단면도.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

90 : 게이트 배선 92 : 데이터 배선

100 : 제 1기판 110 : 게이트 전극

112 : 액티브층 114 : 소스 전극

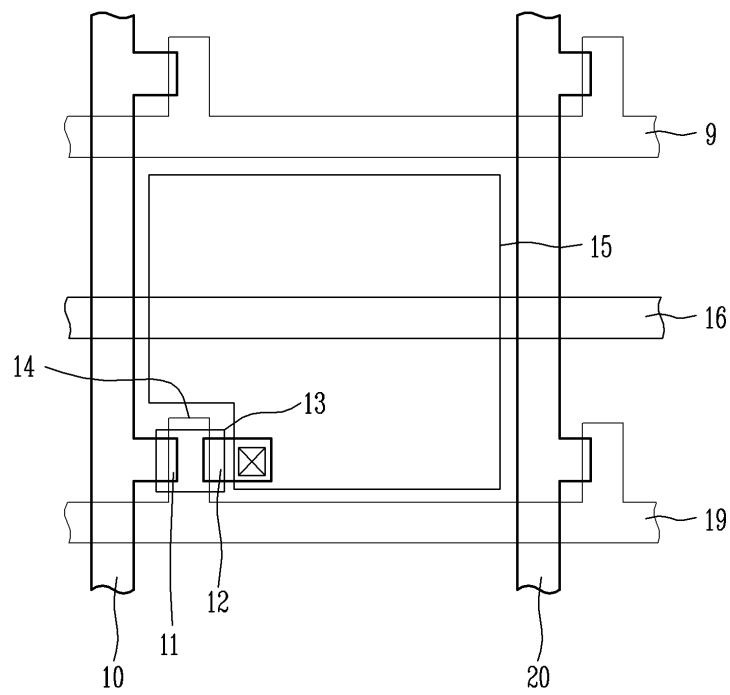
116 : 드레인 전극 120 : 화소 전극

130 : 제 1전극 132 : 절연막

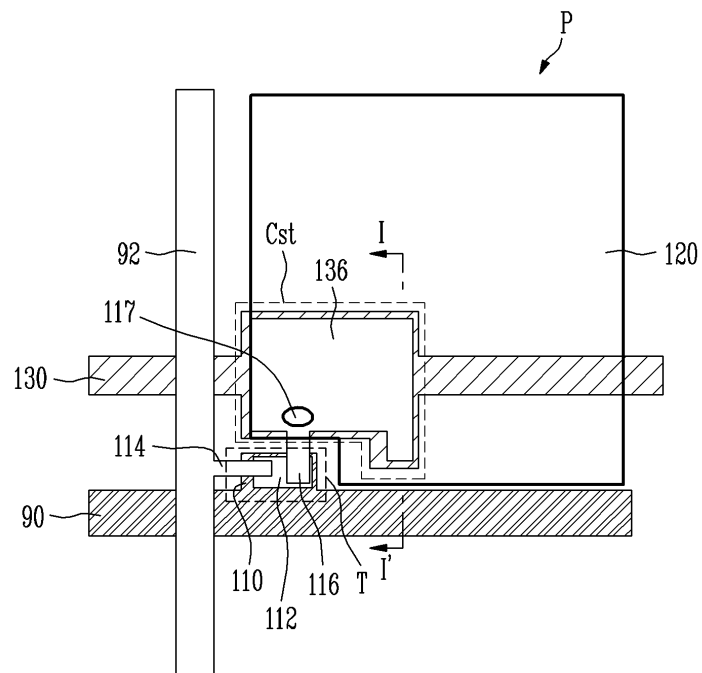
136 : 제 2전극

도면

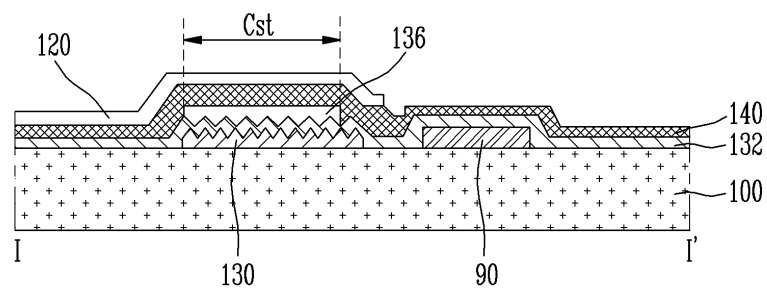
도면1



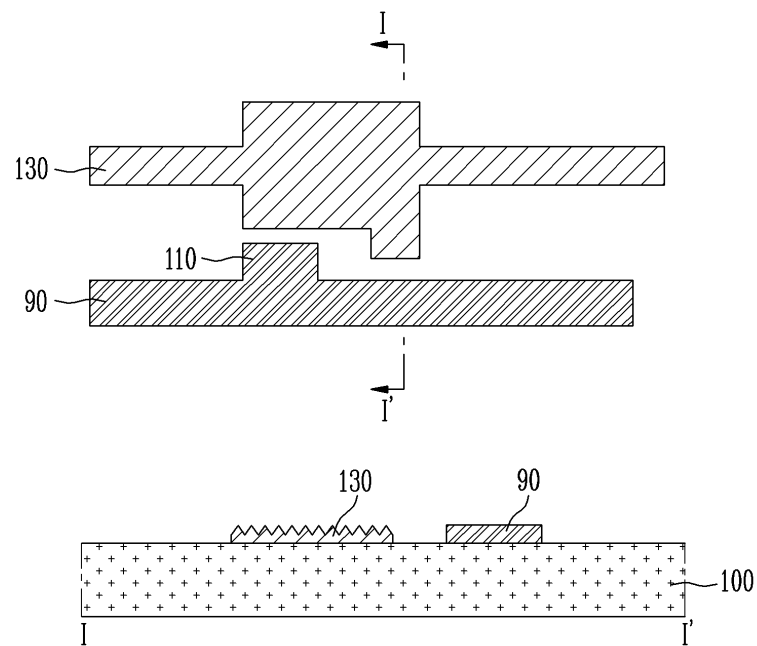
도면2



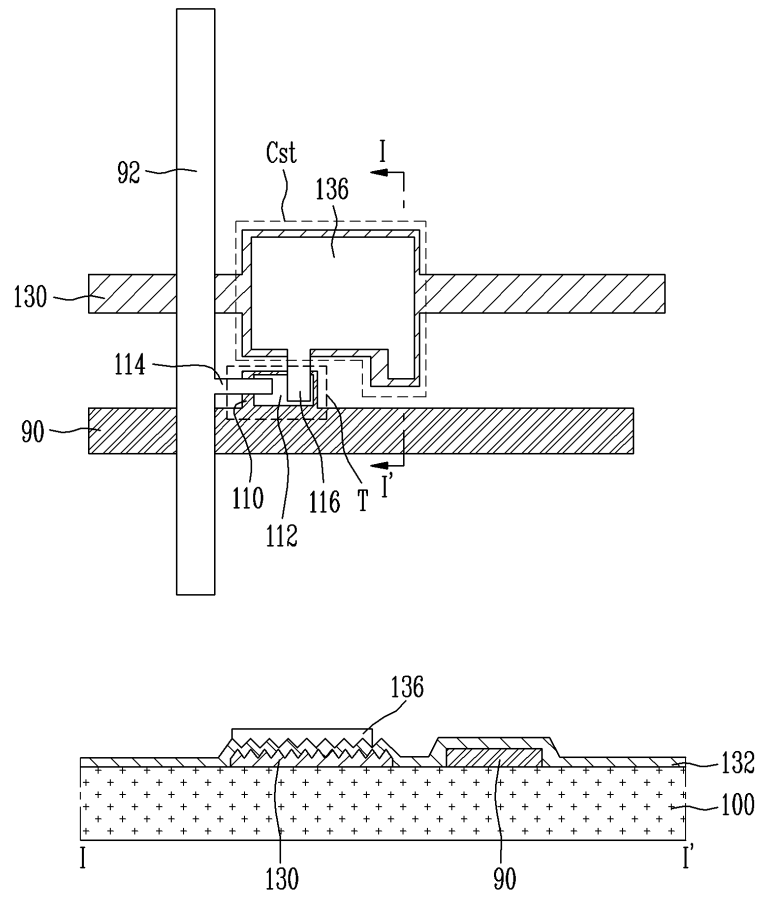
도면3



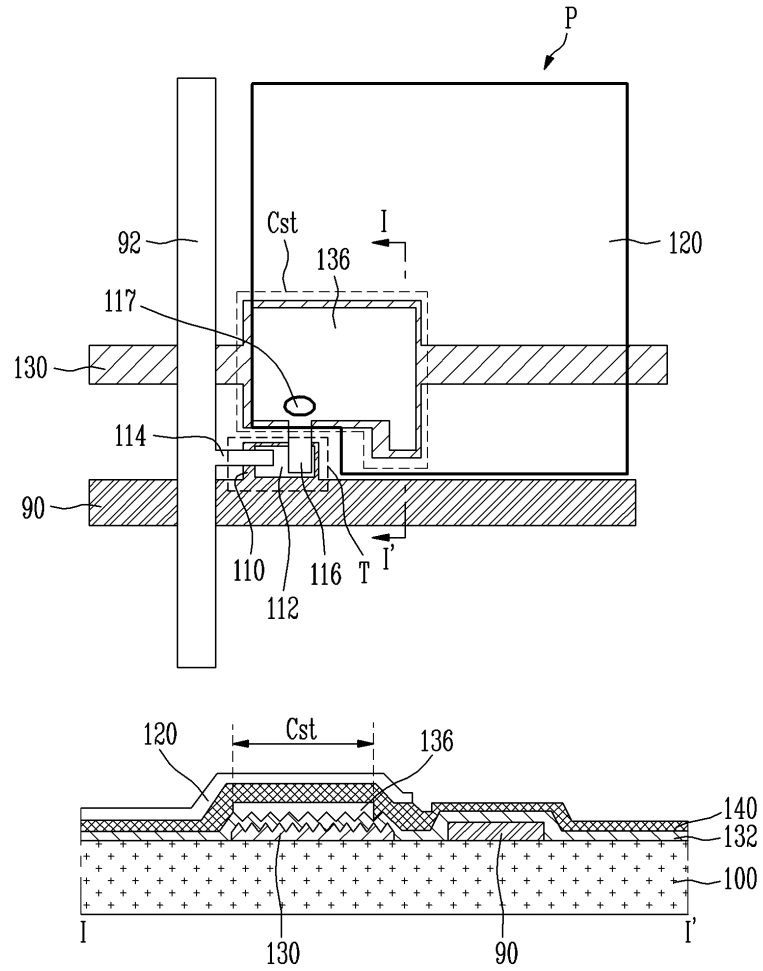
도면4a



도면4b



도면4c



专利名称(译)	液晶显示装置阵列基板及其制造方法		
公开(公告)号	KR1020070054516A	公开(公告)日	2007-05-29
申请号	KR1020050112596	申请日	2005-11-23
申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
[标]发明人	DOYOUNG KIM 김도영 HAEJIN HEO 허해진		
发明人	김도영 허해진		
IPC分类号	G02F1/136		
CPC分类号	G02F1/136213 H01L27/13 H01L27/1214 H01L27/12 G02F2201/40 H01L27/1255 Y10S438/964		
代理人(译)	SHIN , YOUNG MOO		
其他公开文献	KR100754126B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

像素电极与存储电容器第二电极电连接：存储电容器第二电极形成在第一电极上，其中漏电极是整体制成的，薄膜晶体管的漏电极形成在栅极布线，数据线的交叉点中，形成于为了使栅极布线与本发明的实施例的栅极布线和数据线交叉，并且存储电容器第一电极：平行并且在栅极布线中形成为凹凸形状图案和薄膜晶体管。使用与像素电极电连接的漏电极区域可以具有缩小第一和第二电极之间的距离的优点，其形成存储电容器的第二电极，并且使用作为凹凸形状的存储电容器的静电容量增加。相移掩模或狭缝掩模是根据本发明的存储电容器的第一电极。

